

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第3区分

【発行日】平成22年7月1日(2010.7.1)

【公開番号】特開2008-119818(P2008-119818A)

【公開日】平成20年5月29日(2008.5.29)

【年通号数】公開・登録公報2008-021

【出願番号】特願2007-131317(P2007-131317)

【国際特許分類】

B 8 1 B 3/00 (2006.01)

B 8 1 C 1/00 (2006.01)

【F I】

B 8 1 B 3/00

B 8 1 C 1/00

【手続補正書】

【提出日】平成22年5月14日(2010.5.14)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

半導体基板上に形成されたシリコンからなる固定電極と、

前記半導体基板と隙間を設けて機械的に可動な状態で配置されたシリコンからなる可動電極と、

前記可動電極の周囲に形成され且つ前記固定電極の一部を覆うように形成された配線積層部であって、配線を含む前記配線積層部と、

を有し、

少なくとも前記可動電極の上面および側面がタンゲステン(W)またはモリブデン(Mo)によりシリサイド化されていることを特徴とするMEMSデバイス。

【請求項2】

半導体基板上に形成されたシリコンからなる固定電極と、

前記半導体基板と隙間を設けて機械的に可動な状態で配置されたシリコンからなる可動電極と、

前記可動電極の周囲に形成され且つ前記固定電極の一部を覆うように形成された配線積層部であって、配線を含む前記配線積層部と、

を有するMEMSデバイスの製造方法であって、

半導体基板上に固定電極を形成する工程と、

一部が犠牲層上に形成された態様で前記可動電極を形成する工程と、

前記固定電極および前記可動電極の上に前記配線積層部を形成する工程と、

前記配線積層部および前記犠牲層の一部をエッティングにより除去して前記可動電極をリースする工程と、

を有し、

前記可動電極を形成する工程において、前記可動電極の上面および側面をタンゲステン(W)またはモリブデン(Mo)によりシリサイド化する工程を含むことを特徴とするMEMSデバイスの製造方法。

【請求項3】

請求項2に記載のMEMSデバイスの製造方法において、

前記固定電極を形成する工程および前記可動電極を形成する工程の少なくともいずれかの工程で、前記可動電極と前記固定電極との少なくともいずれか一方に不純物イオンをイオン打ち込みする工程を含むことを特徴とするMEMSデバイスの製造方法。